

08. 4. 2004

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

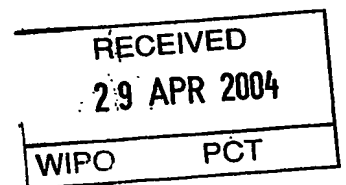
別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2003年 4月 8日

出 願 番 号  
Application Number: 特願2003-104437  
[ST. 10/C]: [JP2003-104437]

出 願 人  
Applicant(s): 東京エレクトロン株式会社

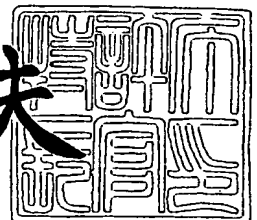


PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 3月12日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 JPP031002

【提出日】 平成15年 4月 8日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C23C 16/40  
H01L 21/316

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBS放送センター  
東京エレクトロン株式会社内

【氏名】 中島 滋

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBS放送センター  
東京エレクトロン株式会社内

【氏名】 崔 東均

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBS放送センター  
東京エレクトロン株式会社内

【氏名】 藤原 友紀

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBS放送センター  
東京エレクトロン株式会社内

【氏名】 池川 寛晃

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBS放送センター  
東京エレクトロン株式会社内

【氏名】 中村 源志

【特許出願人】

【識別番号】 000219967

【氏名又は名称】 東京エレクトロン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100091513

【弁理士】

【氏名又は名称】 井上 俊夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 034359

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9105399

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 成膜方法及び成膜装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 反応容器内にてハフニウム有機化合物とシラン系ガスとを反応させてハフニウムシリケート膜を基板上に成膜することを特徴とする成膜方法。

【請求項 2】 反応容器内は加熱雰囲気であり、ハフニウム有機化合物は蒸気で反応容器内に供給されることを特徴とする請求項 1 記載の成膜方法。

【請求項 3】 シラン系のガスは、モノシランガス及び／またはジシランガスであることを特徴とする請求項 1 または 2 記載の成膜方法。

【請求項 4】 基板上にハフニウム及び酸素を含むハフニウム化合物膜を成膜する工程と、

この工程で得られたハフニウム化合物膜を、窒素及び水素からなる化合物のガスにより加熱雰囲気下でアニールすることを特徴とする成膜方法。

【請求項 5】 窒素及び水素からなる化合物のガスはアンモニアガスである請求項 4 記載の薄膜改質方法。

【請求項 6】 ハフニウム化合物膜がアニールされた後、ハフニウム化合物膜の上にシリコン窒化膜を成膜することを特徴とする請求項 4 または 5 記載の成膜方法。

【請求項 7】 ハフニウム化合物は、ハフニウム有機化合物とシラン系ガスとを反応させて得られたハフニウムシリケート膜であることを特徴とする請求項 4 ないし 6 のいずれかに記載の成膜方法。

【請求項 8】 基板が搬入される反応容器と、

この反応容器内の処理雰囲気を加熱する加熱手段と、

ハフニウム有機化合物の蒸気を前記反応容器に供給するための第 1 のガス供給手段と、

シラン系のガスを前記反応容器に供給するための第 2 のガス供給手段と、

前記反応容器内にてハフニウム有機化合物とシラン系ガスとを反応させてハフニウムシリケート膜を基板上に成膜するように前記加熱手段、第 1 のガス供給手段及び第 2 のガス供給手段を制御する制御手段と、を備えたことを特徴とする成

膜装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、例えばMOSFETのゲート酸化膜あるいはメモリセルの容量素子などの高誘電率膜を成膜する方法及び成膜装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

半導体装置に対しては種々の厳しい要請があり、例えばMOSFETのゲート酸化膜については、リーク電流が小さいこと、耐圧が大きいこと、信頼性が高いことなどが挙げられるが、更に動作速度の向上を図ることから容量をより一層小さくする要請がある。ゲート酸化膜として従来からシリコン酸化膜(SiO<sub>2</sub>)膜が用いられてきたが、ゲート酸化膜の容量を小さくするために膜厚を薄くするとリーク電流が大きくなってしまいうという問題があった。

【0003】

そこでシリコン酸化膜よりも比誘電率の高い高誘電率材料が検討されており、そのような材料であれば、物理的な膜厚を大きくしても電気的膜厚を小さくでき、物理的な膜厚が大きいためにリーク電流を小さくできる利点がある。電気的膜厚とは、シリコン酸化膜に換算したときの換算膜厚に対応するものであり、ある材料についてのシリコン酸化膜の換算膜厚T<sub>0</sub>は、その材料の物理的膜厚及び比誘電率を夫々T<sub>1</sub>及びε<sub>1</sub>とし、シリコン酸化膜の比誘電率をε<sub>0</sub>とすると、(1)式で表される。

【0004】

$$T_0 = (\epsilon_0 / \epsilon_1) \times T_1 \quad (1)$$

このような高誘電率膜としてハフニウム酸化膜(HfO<sub>2</sub>膜)が注目されている。ハフニウム酸化膜は比誘電率がおよそ40であり、シリコン酸化膜の比誘電率が4程度であることから、シリコン酸化膜に比べてかなり高い誘電率を有している。そこで特許文献1には、テトラターシャリープトキシハフニウムなどの有機金属化合物原料と酸素ラジカルあるいは窒化ラジカルとを交互に照射して基板

上にハフニウム酸化膜を成膜することが記載され、更にテトラターシャリープトキシハフニウムとテトラメチルシランとを混合することによりハフニウムシリケート膜が形成されることについて記載されている。また特許文献2には、減圧CVD法によりハフニウムの有機化合物と酸化体ガスである酸素又はオゾンとを反応させてハフニウム酸化膜を成膜することが記載され、ハフニウム及びシリコンを含む有機化合物である液体ソースを原料として用いることが示唆されている。

#### 【0005】

##### 【特許文献1】

特開2002-343790号公報の段落0028、0057

##### 【特許文献2】

特開2002-246388号公報の請求項1、請求項2、請求項15、請求項18及び段落0030

#### 【0006】

##### 【発明が解決しようとする課題】

ところでMOSFETの製造工程においては、ゲート酸化膜を成膜した後、ポリシリコンを積層してこれに例えばボロン、燐を打ち込んでゲート電極とし、その後例えば1000℃程度で短時間のアニールが行われる。このように短時間ではあるが、高温雰囲気にはハフニウム酸化膜が曝されるとハフニウム酸化膜が一部結晶化してしまう。しかしながらハフニウム酸化膜が結晶化すると、結晶粒子（グレイン）同士の間で電流がリークしてしまうので、ゲート酸化膜のリーク電流が大きくなり、ゲート酸化膜として高誘電率の材質を選定しているにもかかわらず良好な電気的特性が得られていない。

#### 【0007】

更にテトラターシャリープトキシハフニウムにテトラメチルシランなどの有機化合物を混合してハフニウムシリケート膜を成膜することにより、シリコンの存在により結晶化温度が改善されるかもしれないが、シリコンの供給源として有機ソースを用いると、ハフニウムシリケート膜中に取り込まれる炭素の量が多くなってしまい、固定電荷の増加、信頼性の低下及び耐圧の減少などの問題がある。またシリコンの含有量が液体ソースの混合比で決まってくるため、シリコンの含

有量の調整が困難であり、ユーザ側で他のプロセス条件などとの絡みで調整を必要とする場合には、対応できない。

#### 【0008】

本発明はこのような事情の下になされたものであり、その目的は、結晶化温度が高いハフニウム化合物膜を成膜する方法及び成膜装置を提供することにある。

#### 【0009】

##### 【課題を解決するための手段】

本発明の成膜方法は、反応容器内にてハフニウム有機化合物とシラン系ガスとを反応させてハフニウムシリケート膜を基板上に成膜することを特徴とする。この成膜方法は例えばCVD (chemical vapor deposition) 法を用いることができ、その場合反応容器内は加熱雰囲気であつ例えば減圧雰囲気であり、ハフニウム有機化合物は蒸気で反応容器内に供給される。シラン系のガスとしては、例えばモノシラン ( $\text{SiH}_4$ ) ガスあるいはジシラン ( $\text{Si}_2\text{H}_6$ ) ガスが用いられる。なおモノシランガス及びジシランガスの両方を供給した場合にも本発明の範囲に含まれる。

#### 【0010】

本発明方法により得られるハフニウムシリケート膜は、シリコンが取り込まれ、シリコンが結晶化を抑制するため、ハフニウムシリケート膜の温度を上げていったときに結晶化に至る温度が高い。従つてハフニウムシリケート膜を成膜した後、例えばハフニウムシリケート膜が高温雰囲気に曝される場合に結晶化しにくくなり、リーク電流が少なくなる。本発明で得られるハフニウムシリケート膜は、例えばMOSFETのゲート酸化膜に適用できるが、その他容量素子などに適用してもよい。

#### 【0011】

また本発明では、基板上にハフニウム酸化膜が成膜された後、窒素及び水素からなる化合物のガス例えばアンモニアガスにより加熱雰囲気下でハフニウム酸化膜をアニールすることが好ましく、このようにすればハフニウム酸化膜の結晶化温度をより高くすることができる。またハフニウム酸化膜がアニールされた後、ハフニウム酸化膜の上にシリコン窒化膜を成膜し、これらの膜により高誘電率膜

を構成してもよい。

#### 【0012】

本発明方法を実施する成膜装置は、基板が搬入される反応容器と、この反応容器内の処理雰囲気を加熱する加熱手段と、ハフニウム有機化合物の蒸気を前記反応容器に供給する第1のガス供給手段と、シラン系のガスを前記反応容器に供給する第2のガス供給手段と、前記反応容器内の圧力を調整する圧力調整手段と、前記反応容器内にてハフニウム有機化合物とシラン系ガスとを反応させてハフニウム酸化膜からなる高誘電率膜を基板上に成膜するように前記加熱手段、第1のガス供給手段、第2のガス供給手段及び圧力調整手段を制御する制御手段と、を備えたことを特徴とする。

#### 【0013】

##### 【発明の実施の形態】

以下に本発明の成膜方法の実施の形態を説明するにあたり、先ず成膜方法を実施するための成膜装置について図1を参照しながら説明する。図1は、縦型熱処理装置であるバッチ式の減圧CVD装置であり、図1中の1は、例えば石英で作られた内管1a及び外管1bよりなる二重管構造の反応容器である反応管である。反応管1の下部側には金属製の筒状のマニホールド11が設けられている。前記内管1aは上端が開口されており、マニホールド11の内方側にて支持されている。外管1bは上端が塞がれており、下端がマニホールド11の上端に気密に接合されている。12はベースプレートである。

#### 【0014】

図1は反応管1内にウエハWが搬入されて成膜処理する状態を示しており、前記反応管1内には、複数枚の被処理体をなすウエハWが各々水平な状態で上下に間隔をおいて保持具である石英製のウエハポート2に棚状に載置されている。より具体的にはこのウエハポート2には、例えば25枚の製品ウエハが搭載され、その上下にダミーウエハなどが搭載される。ウエハポート2は蓋体21の上に例えば石英製の保温ユニット22の設置領域を介して保持されている。保温ユニッ



トは 22 は石英フィンなどの断熱ユニット及び発熱体ユニットを組み合わせで成り、その中央には、回転軸 23 が貫通していてボートエレベータ 24 に設けられたモータ M により回転軸 23 を介してウエハボート 2 が回転する。

#### 【0015】

前記蓋体 21 は、ウエハボート 2 を反応管 1 内に搬入、搬出するためのボートエレベータ 24 の上に搭載されており、上限位置にあるときにはマニホールド 11 の下端開口部を閉塞する役割を持つものである。

#### 【0016】

また反応管 1 の周囲には、これを取り囲むように例えば抵抗発熱ヒータ素線よりなる加熱手段であるヒータ 30 が設けられている。このヒータ 30 の一例としては、例えば細い高純度のカーボンファイバの束を複数用いて編み込むことにより形成された線状の可撓性のカーボンワイヤを例えば透明な石英管の中に封入して構成されたものなどを挙げることができる。この例では反応管 1 内の熱処理雰囲気の大部分を受け持つメインヒータ及びその上下に配置されたサブヒータ並びに天井部に設けられたサブヒータが設けられているが、符号は便宜上全て「30」を付してある。なおヒータ 30 の周囲には図示していないが、炉本体が設けられる。

#### 【0017】

前記マニホールド 11 の周囲には、第 1 のガス供給管 4、第 2 のガス供給管 5 及び第 3 のガス供給管 6 が設けられ、夫々内管 1a の中にガスを供給できるようになっている。第 1 のガス供給管 4 には、上流側からハフニウム有機化合物例えばテトラターシャリーブトキシハフニウム ( $\text{Hf} [\text{OC} (\text{CH}_3)_3]_4$ ) の供給源 41、バルブ 42、液体マスフローコントローラ 43、気化器 44 及びバルブ 45 がこの順に設けられている。ハフニウム有機化合物供給源 41 は、例えばハフニウム有機化合物である液体ソースを貯留したタンクからガス圧によって液体ソースが押し出されるように構成されている。

#### 【0018】

第 2 のガス供給管 5 には上流側からシラン系のガス例えばジシラン ( $\text{Si}_2\text{H}_6$ ) ガスの供給源 51、バルブ 52、流量調整部であるマスフローコントローラ 5

3 及びバルブ 5 4 がこの順に設けられている。また第 3 のガス供給管 6 には上流側からアンモニア (NH<sub>3</sub>) ガスの供給源 6 1、バルブ 6 2、流量調整部であるマスフローコントローラ 6 3 及びバルブ 6 4 がこの順に設けられている。なお各ガス供給管 4 ~ 6 に夫々設けられているバルブなどのガス供給機器群は、夫々第 1 のガス供給手段 4 0、第 2 のガス供給手段 5 0 及び第 3 のガス供給手段 6 0 を構成している。またアンモニアガスを供給するための第 3 のガス供給管 6 は、この実施の形態では使用しないが、その後述べる実施の形態で使用される。

#### 【0019】

前記マニホールド 1 1 には、内管 1 a と外管 1 b との間の空間から排気できるように排気管 1 3 が接続されており、この排気管 1 3 には、圧力調整部 1 4 を介して図示しない真空ポンプが接続されている。

#### 【0020】

更にこの減圧 CVD 装置はコンピュータからなる制御部 7 を備えている。この制御部 7 は、処理プログラムを起動し、図示しないメモリ内のプロセスレシピの記載事項を読み出してそのレシピに基づいて処理条件を制御する機能を有し、ヒータ 3 0、圧力調整部 1 4 及び第 1 ~ 第 3 のガス供給手段 4 0 ~ 6 0 を制御するための制御信号を出力する。

#### 【0021】

次に上述の減圧 CVD 装置を用いて実施する成膜方法の一例について述べる。先ず基板である半導体ウエハ (以下ウエハという。) W、例えば N 型あるいは P 型のシリコン膜が表面に形成されたウエハ W を所定枚数ウエハポート 2 に棚状に保持してポートエレベータ 2 4 を上昇させることにより反応管 1 内に搬入する (図 1 の状態)。ウエハポート 2 が搬入されてマニホールド 1 1 の下端開口部が蓋体 2 1 により塞がれた後、反応管 1 内の温度を例えば 200 ~ 300 °C の範囲で設定されたプロセス温度に安定させ、排気管 1 3 を通じて真空ポンプ 1 5 により所定の真空度に反応容器内を真空排気する。

#### 【0022】

そして反応容器内がプロセス温度に安定した後、ハフニウム有機化合物の供給源 4 1 から液体のテトラターシャリープトキシハフニウムを吐出すると共に、液

体マスフローコントローラ 43 により例えば  $0.02 \text{ sccm} \sim 1 \text{ sccm}$  の流量に調整して気化器 44 で気化しその蒸気を第 1 のガス供給管 4 を介して反応管 1 内に供給する。また第 2 のガス供給管 5 からシラン系ガスであるジシランガスをマスフローコントローラ 53 により例えば  $50 \sim 1000 \text{ sccm}$  の流量に調整して反応管 1 内に供給する。更に圧力調整部 14 により反応管 1 内の圧力を例えば  $26.6 \text{ Pa} \sim 133 \text{ Pa}$  ( $0.2 \sim 1.0 \text{ Torr}$ ) の減圧雰囲気調整する。反応管 1 内ではテトラターシャリープトキシハフニウム及びジシランガスが熱分解し、ハフニウム、酸素及びシリコンを含む薄膜 (ハフニウムシリケート膜) がウエハ W 上に成膜される。このときウエハポート 2 はモータ M により回転している。こうして成膜処理が所定時間行われた後、成膜ガスの供給を停止し、反応管 1 内を不活性ガスで置換し、ウエハポート 2 を反応管 1 から搬出 (アンロード) する。なお搬出されたウエハ W は、その後例えば別の装置によりゲート電極をなすポリシリコン膜の成膜工程が行われる。

#### 【0023】

上述実施の形態によれば、ハフニウム及び酸素の他にシリコンが含まれるハフニウムシリケート膜が成膜され、シリコンはハフニウム酸化物の結晶化を抑える働きがあるので、後述の実施例からも明らかなように得られたハフニウム化合物膜である高誘電率膜は結晶化温度が高い。このため例えば MOSFET の製造工程においてハフニウムシリケート膜の上のポリシリコン膜に対して高温アニール処理がされても、ハフニウムシリケート膜の結晶化が抑えられ、このためハフニウムシリケート膜からなるゲート酸化膜のリーク電流が少なくなり、電気的特性の良好な MOSFET が得られる。

#### 【0024】

そしてハフニウム化合物膜中にシリコンを含有させるために分解温度の低いジシランガスを用いているので、シリコンの含有量を多くすることができ、結晶化抑制効果が大きく、また有機シリコンソースを用いる場合のように炭素の含有量が多くなることが避けられる。

#### 【0025】

この実施の形態ではシラン系ガスとしてジシランガスを用いているが、モノシ

ランガスを用いてもよいし、その他  $\text{Si}_n\text{H}_{(2n+2)}$  で表されるガスを用いてもよい。

#### 【0026】

次に本発明の他の実施の形態について述べると、この実施の形態ではハフニウム化合物膜を加熱した状態で当該膜に窒素と水素との化合物例えばアンモニア ( $\text{NH}_3$ ) ガスを供給してアニール処理 (改質処理) を行う。ハフニウム化合物膜として、例えば上述実施の形態の手法により成膜したハフニウムシリケート膜を用いる場合には、図1の成膜装置によりハフニウムシリケート膜を基板上に成膜した後、基板を反応管1から搬出させずにつまり大気雰囲気にならずことなく連続して処理することができる。図1の成膜装置では、第3のガス供給管6によりアンモニアガスを反応管1内に供給できるようになっているので、ウェハW上にハフニウムシリケート膜を成膜した後、反応管1内のガスを排出するために図示しない真空ポンプで引き切り、その状態で例えば反応管1内を  $500 \sim 900^\circ\text{C}$  に昇温する。その後アンモニアガスを反応管1内に例えば  $2 \text{ s l m}$  の流量で供給しながら反応管1内の圧力を例えば  $2.66 \times 10^2 \sim 1.60 \times 10^4 \text{ Pa}$  ( $2 \sim 120 \text{ Torr}$ ) となるように調整し、例えば  $5 \sim 60$  分間アニール処理を行う。このような一連の処理は、制御部7が所定のレシピを読み出して各部を制御することによって行われる。

#### 【0027】

図2は一連のプロセスを模式的に記載した図であり、図2 (a)、(b) はP型シリコン膜81の上にテトラターシャリーブトキシハフニウム及びジシランガスによりハフニウムシリケート膜82を成膜する様子であり、図2 (c) は、ハフニウムシリケート膜82に対してアニール処理を行っている様子を示す図である。このようにハフニウム化合物膜例えばハフニウムシリケート膜をアンモニアによりアニールすると、後述の実施例から明らかなように結晶化温度が例えば  $50^\circ\text{C}$  程度向上する。その理由については明らかでないが、 $\text{Si}-\text{N}$  及び  $\text{Hf}-\text{N}$  の結合が形成され、これにより  $\text{HfO}_2$  と  $\text{SiO}_2$  とが相分離することを抑制し、結晶化が抑制されていると考えられる。なおこの例ではハフニウムシリケート膜をアニールしているが、例えばテトラターシャリーブトキシハフニウムを熱分解

して得たハフニウム酸化膜であってもよいし、その他のハフニウム化合物膜であってもよい。またハフニウム化合物膜の成膜とアンモニアによるアニール処理とを別個の装置で行うようにしてもよい。

#### 【0028】

更に図3は本発明の更に他の実施の形態を示す図である。図3(a)～(c)までは図2に示した例と同じであるが、この例では、アンモニアでアニールしたハフニウムシリケート膜82の上に図3(d)、(e)に示すように例えばアンモニアガスとジクロロシラン( $\text{SiH}_2\text{Cl}_2$ )ガスとを用いてシリコン窒化膜( $\text{Si}_3\text{N}_4$ )83を成膜し、図3(f)に示すように、このシリコン窒化膜83の上にゲート電極となるポリシリコン膜84を成膜する。なお図3(f)では、積層体に電圧を印加して電気的特性を評価するときにはシリコン膜81はN型シリコン膜を用いることからシリコン膜81はN型の表示をしてある。

#### 【0029】

このような製造工程でゲート電極構造を製作すると、ハフニウムシリケート膜82の上に直接ポリシリコン膜84を積層したときに比べて後述の実施例からも明らかなようにゲート電極とシリコン膜81との間に電圧を印加したときのフラットバンド電圧( $V_{fb}$ )が抑制される。これはハフニウムシリケート膜の上に直接ポリシリコン膜を成膜すると、両者の膜の界面で何らかの反応物質が生成されてこの反応物質が要因となって $V_{fb}$ シフトが増え、そしてこの間に窒化シリコン膜83を介在させるとこれがバリア層となって、両者の反応が阻止されるものと思われる。

#### 【0030】

ここでハフニウム有機化合物としてはテトラターシャリープトキシハフニウムに限らず、 $\text{Hf}(\text{OC}_3\text{H}_7)_4$ などの他のハフニウムアルコキシドであってもよい。更にハフニウム化合物膜に対してアニールするときに用いるガスとしては、窒素及び水素からなる化合物のガスとしてアンモニアガスを挙げたが、例えばヒドラジン( $\text{N}_2\text{H}_2$ )であってもよい。更にまた上述の実施の形態では、高誘電率膜の用途としてゲート酸化膜を挙げたが、本発明で得られる高誘電率膜は、容量素子例えばメモリに用いられる容量素子として使用されるものであってもよい。

また成膜装置としてはバッチ式のものに限らず枚葉式のものであってもよい。

### 【0031】

#### 【実施例】

##### 実施例 1

図1の縦型熱処理装置である成膜装置を用い、反応容器内の処理雰囲気温度を200～300℃に設定し、処理雰囲気圧力を40～60Paに維持しながらテトラターシャリープトキシハフニウムを液体流量で0.1～0.5sccm、ジシランガスを100～200sccmで反応容器内に供給し、P型シリコン膜が表面に形成されている複数枚のシリコン基板の上に、膜厚が約15nmのハフニウムシリケート膜を成膜した。

### 【0032】

得られた基板がどれくらいの温度で結晶化するかを調べるためにこれら基板を4つのグループに分け、これら4つのグループの基板について夫々800℃、850℃、900℃及び950℃の温度で不活性雰囲気下で1分間加熱した。そしてアニール後の基板表面の薄膜に対してX線回折分析を行い結晶の有無を調べたところ図4に示す結果が得られた。この結果から分かるように900℃で加熱した基板については、 $2\theta$ が30°付近のところで酸化ハフニウム(111)のピークが現れているが、850℃で加熱した基板についてはピークが現れていない。従ってこの実施例で得られたハフニウムシリケート膜は、850℃では結晶化しないことが分かる。

### 【0033】

##### 実施例 2

実施例1においてジシランガスの代わりにモノシランガスを用いた他は同様にしてハフニウムシリケート膜を同様の基板上に成膜し、膜厚が約15nmのハフニウムシリケート膜を得た。そしてこの基板を同様に加熱し、その後X線回折分析を行ったところ、図5に示す結果が得られた。この結果から分かるように850℃で加熱した基板については、ピークが現れているが、800℃で加熱した基板についてはピークが現れていない。従ってこの実施例で得られたハフニウムシリケート膜は、800℃では結晶化しないことが分かる。

## 【0034】

このようにモノシランガスを用いた場合でもハフニウムシリケート膜の結晶化温度が高いことが裏付けられているが、ジシランガスを用いた場合に比べて結晶化温度が低くなっている。この理由は、ジシランガスは分解温度がモノシランガスよりも低いため、モノシランガスを用いた場合よりも膜中に取り込まれるシリコンの量が多く、このためシリコンの含有量つまり膜中のハフニウムに対するシリコンの組成比が多いことに起因していると考えられる。

## 【0035】

## 比較例 1

実施例 1 と同じ装置を用い、処理雰囲気温度を同じにして、処理雰囲気圧力を 40 Pa に維持しながらテトラターシャリーブトキシハフニウムを液体流量で 0.1 sccm、酸素ガスを 1 slm 反応容器内に供給し、P 型シリコン膜が表面に形成されている複数枚のシリコン基板の上に、膜厚が 15 nm の酸化ハフニウム膜を成膜した。即ちこの例においてはシラン系ガスを用いていない。

## 【0036】

これらシリコン基板を 3 つのグループに分け、3 つのグループの基板について夫々 450℃、600℃及び 800℃の温度で不活性雰囲気下で 1 分間加熱しアニールした。その後の基板表面の薄膜に対して同様の分析を行ったところ図 6 に示す結果が得られた。この結果から分かるように 450℃で加熱した基板については、 $2\theta$  が 30° 付近のところで酸化ハフニウム (111) のピークが現れていないが、600℃で加熱した基板についてはピークが現れている。従ってこの比較例 1 で得られた酸化ハフニウム膜は、600℃では結晶化し、実施例 1、2 と比較して結晶化に至る温度が低い。即ちモノシランガスやジシランガスを原料ガスとして用いることにより、ハフニウム化合物ガスの結晶化温度が向上することが理解される。

## 【0037】

## 実施例 3

実施例 1 と同様にして（ジシランガスを使用）同様の基板の上に膜厚 12.63 nm のハフニウムシリケート膜を成膜し、次いでこのハフニウムシリケート膜を

成膜した装置とは別の縦型熱処理装置を用いて、当該膜に対してアンモニアガス雰囲気下でアニールした。アニール温度は $600\sim 900^{\circ}\text{C}$ 、圧力は $2.66\times 10^2\sim 1.60\times 10^4\text{ Pa}$  ( $2\sim 120\text{ Torr}$ )、アンモニアガスの流量は $2\text{ slm}$ 、アニール時間は $5\sim 60$ 分に設定した。アニール後の基板を実施例1と同様に加熱し、基板表面の薄膜に対して同様の分析を行ったところ、図7に示す結果が得られた。この結果から分かるように $950^{\circ}\text{C}$ で加熱した基板については、ピークが現れているが、 $900^{\circ}\text{C}$ で加熱した基板についてはピークが現れていない。従ってこの実施例3で得られたハフニウムシリケート膜は、 $900^{\circ}\text{C}$ では結晶化しないことが分かる。また実施例1では $900^{\circ}\text{C}$ では結晶化していることから、アンモニアによりアニールすることによりハフニウムシリケート膜の結晶化温度が高くなることが分かる。

#### 【0038】

更にまたアンモニアを用いたアニールを行う前の基板とアニール後の基板との各々について、ハフニウムシリケート膜の上にポリシリコン膜を成膜し、このポリシリコン膜にボロンを打ち込んでゲート電極を構成し、ゲート電極とN型シリコン膜との間に電圧を印加し、その間の容量を求めてそれらの値から電氣的膜厚を求めた。アニールを行わないハフニウムシリケート膜の電氣的膜厚は $1.6\text{ nm}$ であったが、アニールを行ったハフニウムシリケート膜の電氣的膜厚は $1.2\text{ nm}$ であった。従ってハフニウム化合物膜に対してアンモニア雰囲気下でアニールを行うことにより、電氣的膜厚が小さくなる、つまり比誘電率が高くなることが分かる。

#### 【0039】

##### 実施例4

実施例2と同様にして（モノシランガスを使用）同様の基板上に膜厚 $12.63\text{ nm}$ のハフニウムシリケート膜を成膜し、次いで実施例3と同様にして当該膜に対してアンモニアガス雰囲気下でアニールした。そしてハフニウムシリケート膜に対して同様に加熱し、その後X線回折分析を行ったところ、図8に示す結果が得られた。この結果から分かるように $900^{\circ}\text{C}$ で加熱した基板については、ピークが現れているが、 $850^{\circ}\text{C}$ で加熱した基板についてはピークが現れていない



。従ってこの実施例で得られたハフニウムシリケート膜は、850℃では結晶化しないことが分かる。また実施例2では850℃では結晶化していることから、モノシランガスを用いてハフニウムシリケート膜を成膜した場合においても、アンモニアによりアニールすることによりハフニウムシリケート膜の結晶化温度が高くなることが分かる。

#### 【0040】

##### 実施例5

実施例3のように、ジシランガスを用いてハフニウムシリケート膜を成膜し、次いでこの膜をアンモニア雰囲気下でアニールし、その後ハフニウムシリケート膜の上に、ジクロルシランガス及びアンモニアガスを用いて減圧CVDにより窒化シリコン膜を成膜した。アンモニアを用いたアニール後のハフニウムシリケート膜の膜厚は、2～3nm、窒化シリコン膜の膜厚は0.5～1.5nmである。更に窒化シリコン膜の上に実施例3と同様にしてゲート電極をなすポリシリコン膜を形成し、ゲート電極とP型シリコン膜との間に電圧を印加して印加電圧と容量との関係を調べたところ、図9の(1)に示す結果が得られた。

#### 【0041】

##### 比較例3

窒化シリコン膜を成膜しないことの他は、実施例5と同様にして同様の試験を行った。ただしハフニウムシリケート膜の膜厚は実施例5の積層体とほぼ同じ膜厚にした。試験結果は図9の(2)に示す通りである。この結果及び実施例5の結果からハフニウムシリケート膜の上に窒化シリコン膜を積層し、この積層体をゲートの容量膜とすることにより、より一層電気特性が改善されることが理解される。

#### 【0042】

##### 【発明の効果】

以上のように本発明によれば、シリコンが取り込まれたハフニウム化合物膜（ハフニウムシリケート膜）が得られ、このシリコンによる結晶化抑制の働きにより結晶化温度の高いハフニウム化合物膜が得られる。従って例えばこのハフニウム化合物膜がその後のプロセスで高温雰囲気に曝されても結晶化が抑えられ、電

圧を印加したときのリーク電流が少ない。そしてシリコンの添加源としてモノシランガスあるいはジシランガスなどのシラン系ガスを用いているので、ガスの供給量を調整することによりシリコンの含有量を自由に簡単に調整できる。また他の発明によれば、ハフニウム化合物膜を、アンモニアガスなどにより加熱雰囲気下でアニールしているため、実施例からも明らかなように結晶化温度の高いハフニウム化合物膜が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の実施の形態に係る成膜装置の一例を示す縦断側面図である。

【図 2】

本発明方法の他の実施の形態により成膜される様子を示す説明図である。

【図 3】

本発明方法の更に他の実施の形態により成膜される様子を示す説明図である。

【図 4】

ハフニウム有機化合物とジシランガスとを用いて得られたハフニウムシリケート膜の結晶化温度を X 線回折により調べた結果を示す特性図である。

【図 5】

ハフニウム有機化合物とモノシランガスとを用いて得られたハフニウムシリケート膜の結晶化温度を X 線回折により調べた結果を示す特性図である。

【図 6】

ハフニウム酸化膜を成膜した後、結晶化温度を X 線回折により調べた結果を示す特性図である。

【図 7】

ジシランを用いたハフニウムシリケート膜をアンモニアガスによりアニールした後、結晶化温度を X 線回折により調べた結果を示す特性図である。

【図 8】

モノシランを用いたハフニウムシリケート膜をアンモニアガスによりアニールした後、結晶化温度を X 線回折により調べた結果を示す特性図である。

## 【図 9】

アンモニアガスによりアニールしたジシランを用いたハフニウムシリケート膜に窒化シリコン膜を積層し、これら積層膜について容量、電圧特性を調べた結果を示す特性図である。

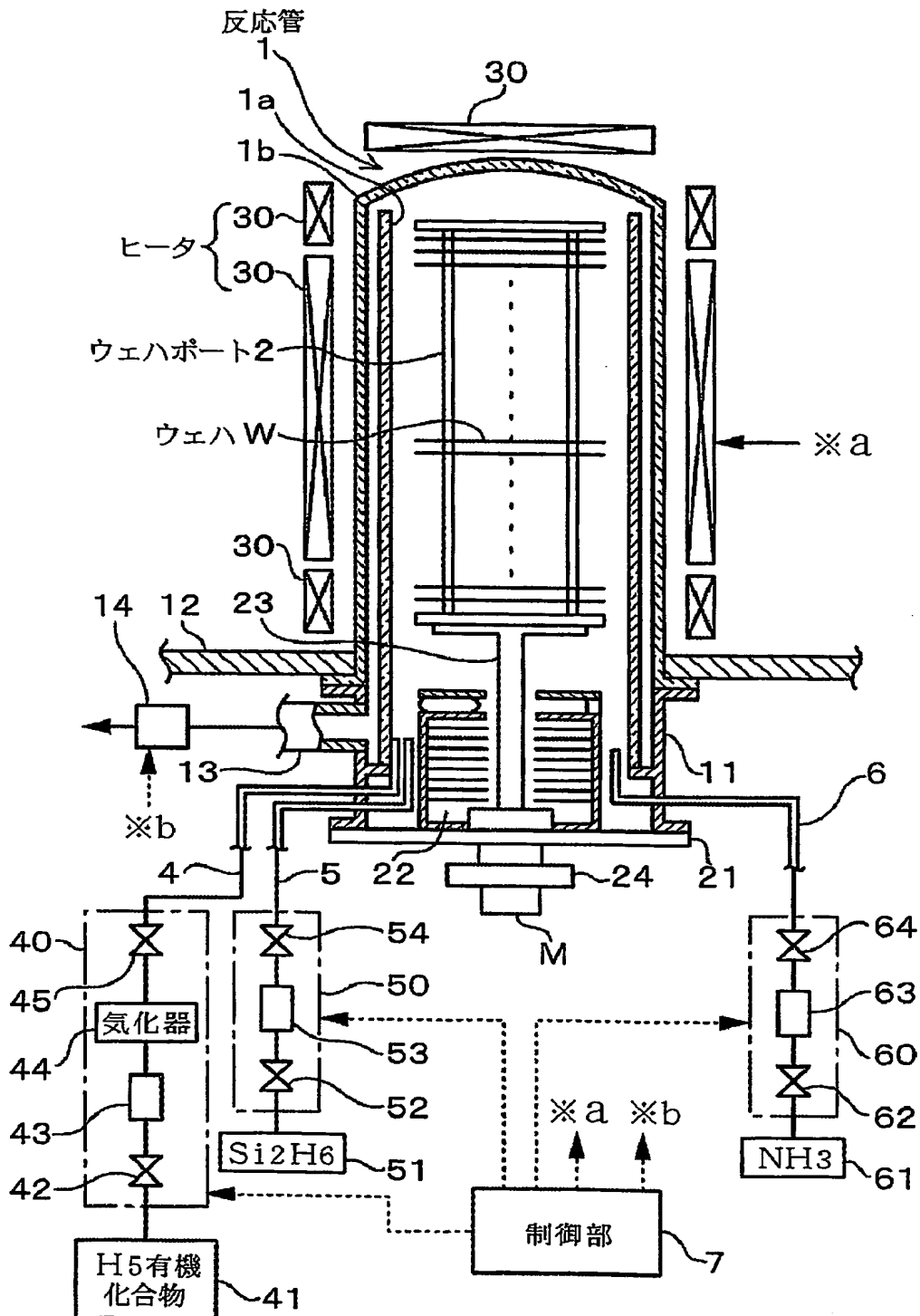
## 【符号の説明】

W	半導体ウエハ
1	反応管
1 1	マニホールド
1 3	排気管
2	ウエハポート
3	ヒータ
4	第 1 のガス供給管
4 0	第 1 のガス供給手段
5	第 2 のガス供給管
5 0	第 2 のガス供給手段
6	第 3 のガス供給管
6 0	第 3 のガス供給手段
7	制御部
8 1	P 型シリコン膜
8 2	ハフニウムシリケート膜
8 3	窒化シリコン膜

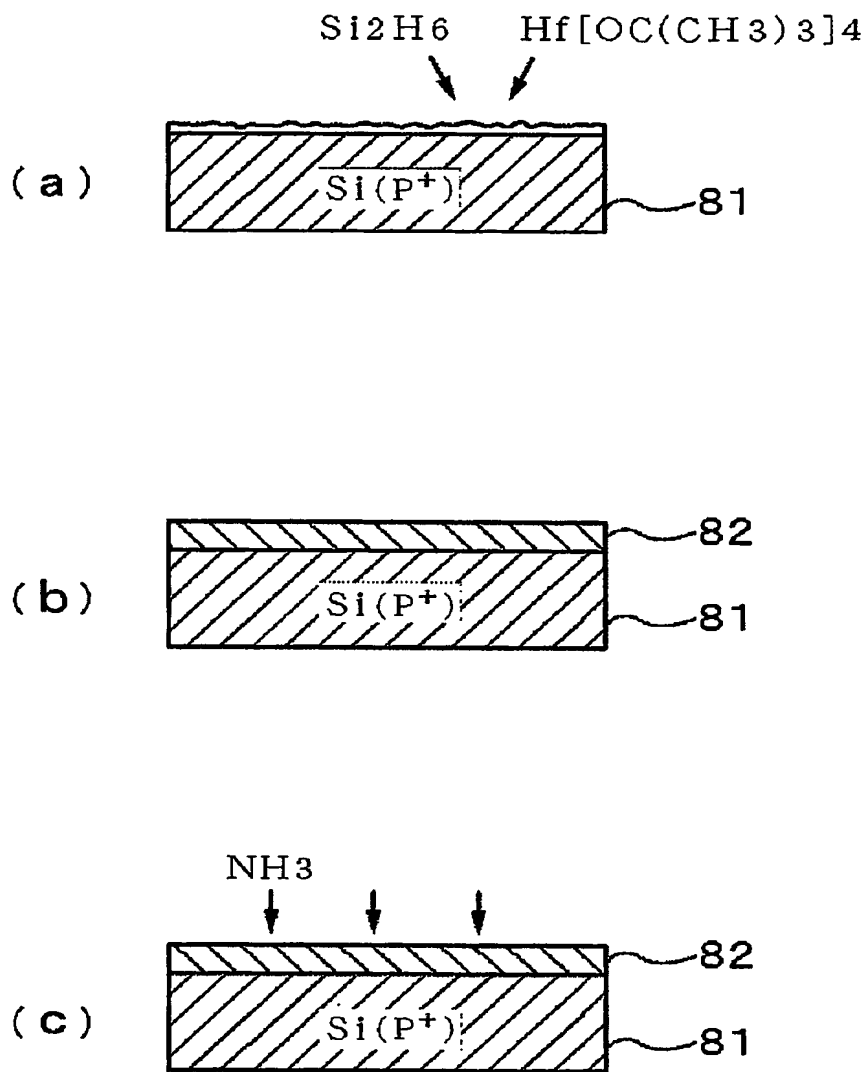
【書類名】

凶面

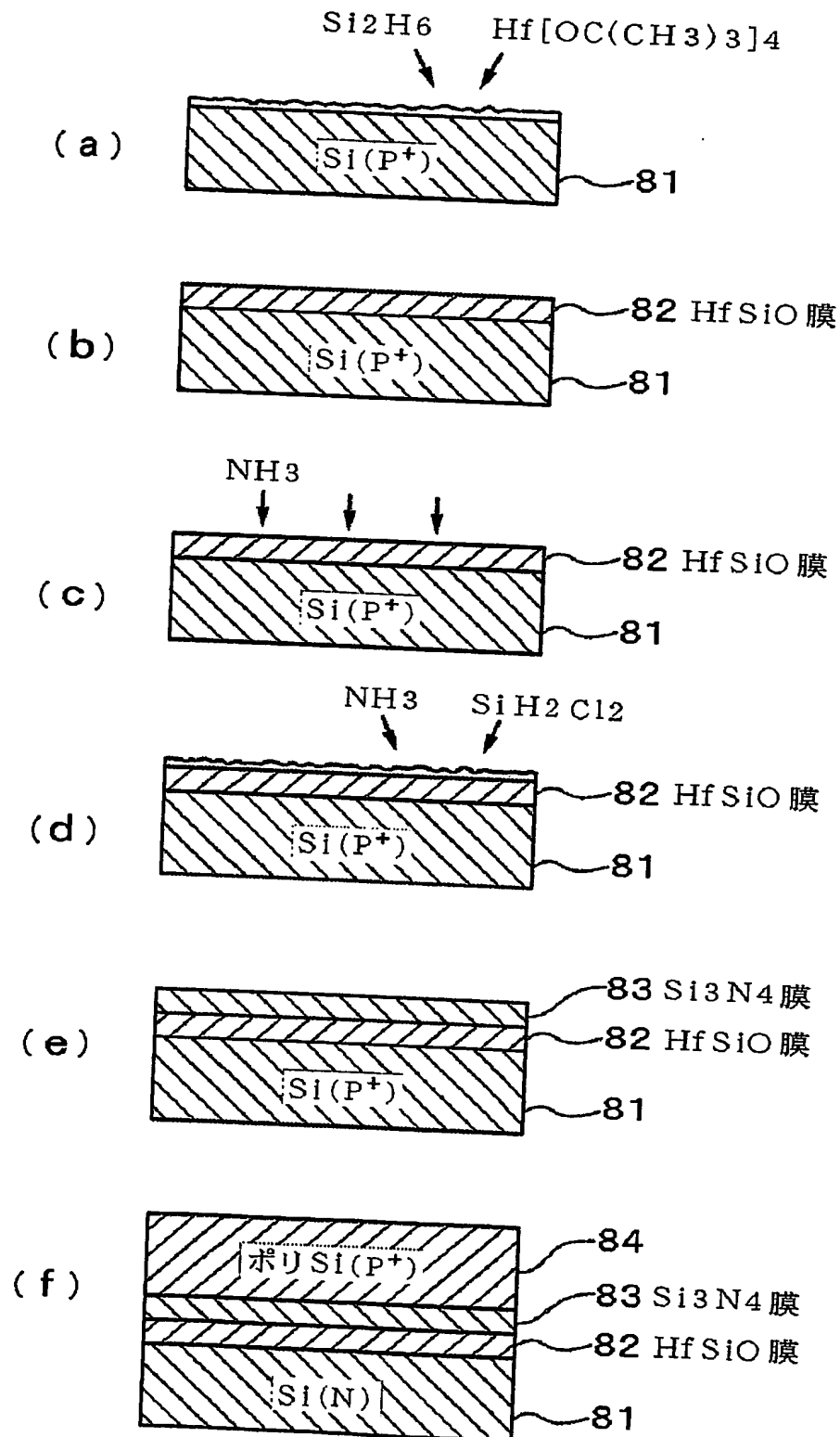
【図 1】



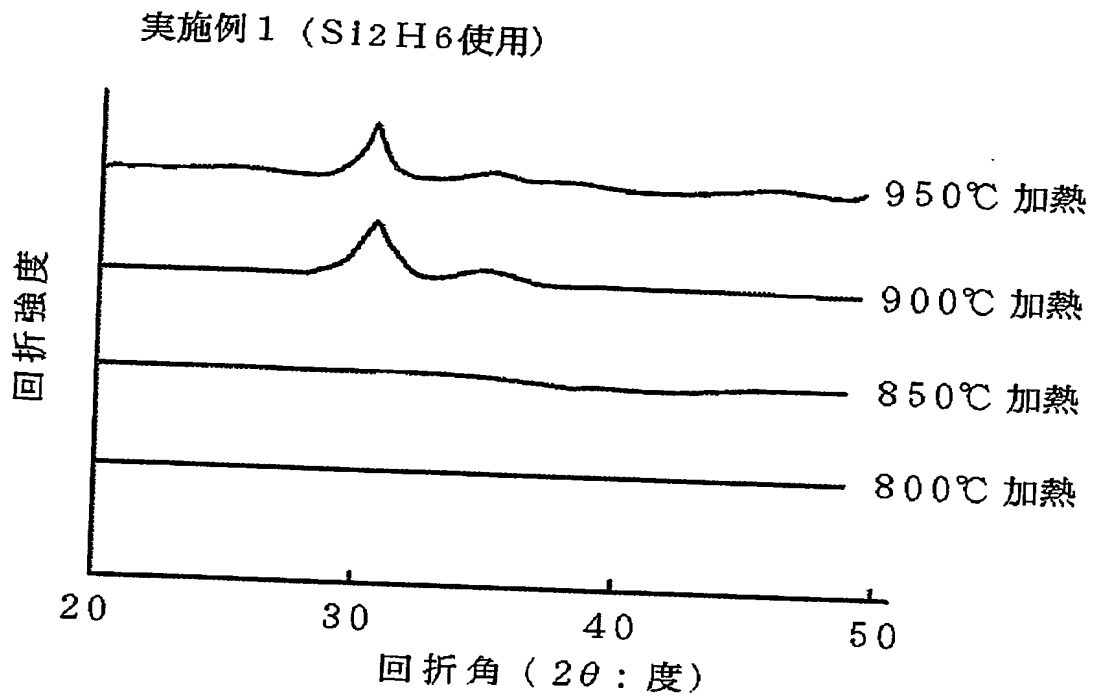
【図 2】



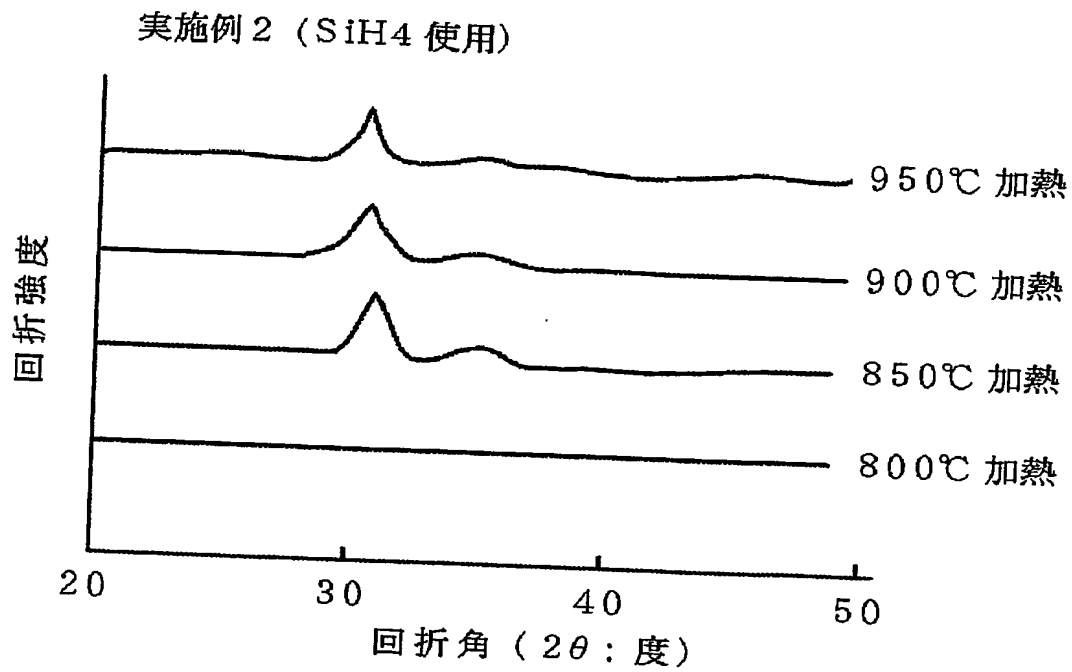
【図3】



【図 4】

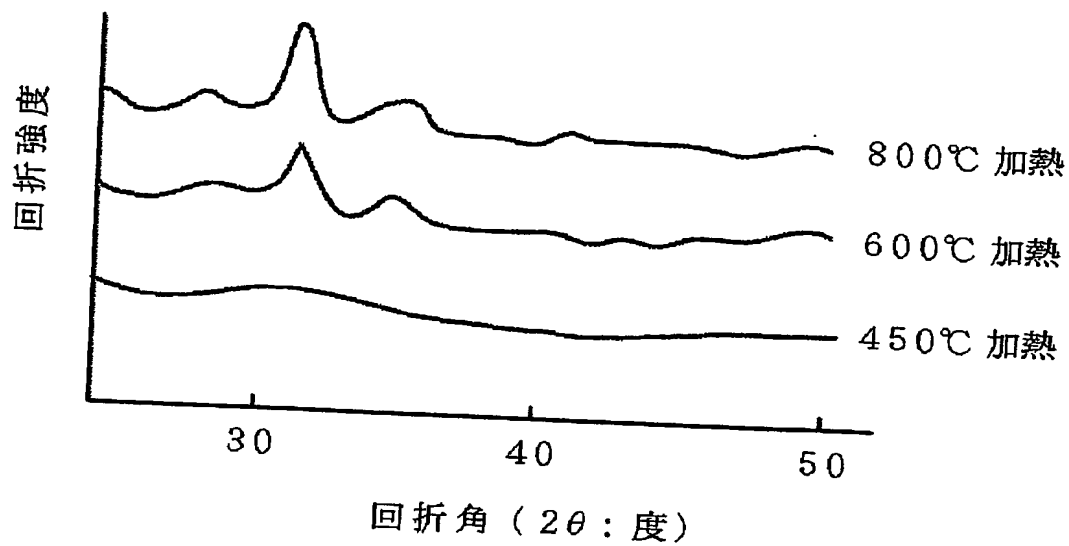


【図 5】



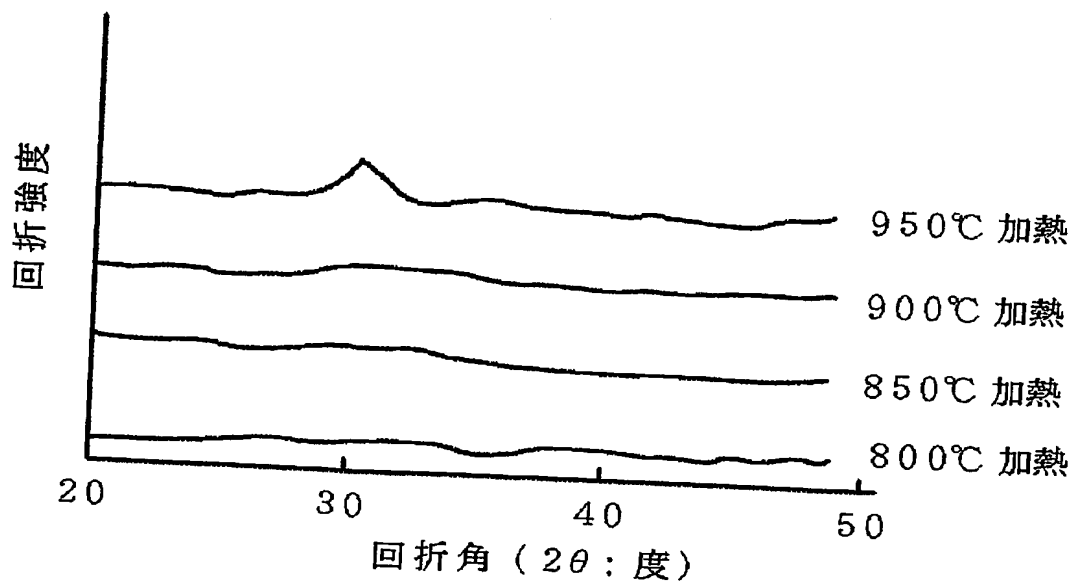
【図6】

比較例1 (シラン系ガスを用いない)



【図7】

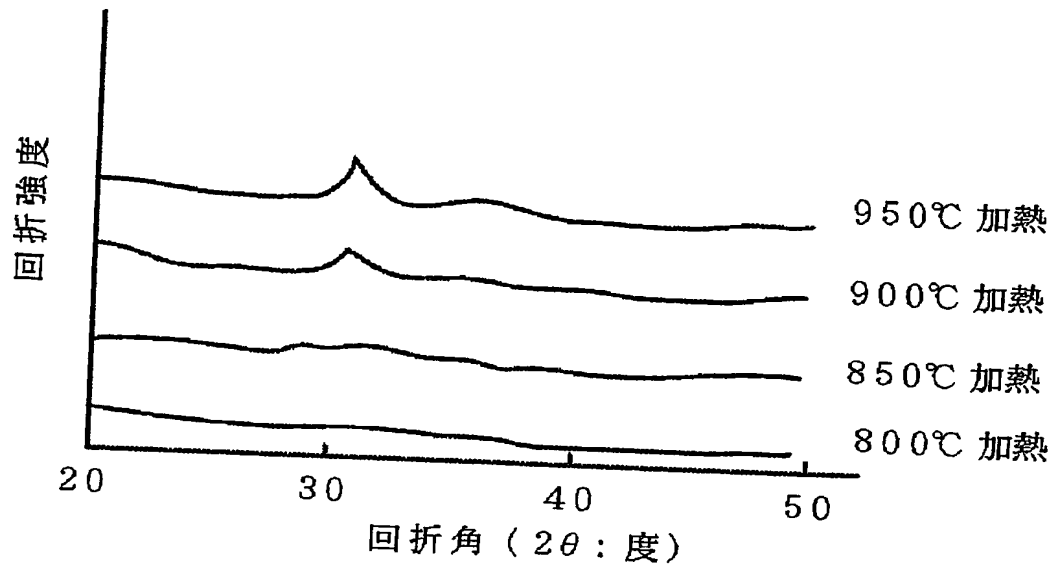
実施例3 (Si<sub>2</sub>H<sub>6</sub> 使用 + NH<sub>3</sub> アニール)



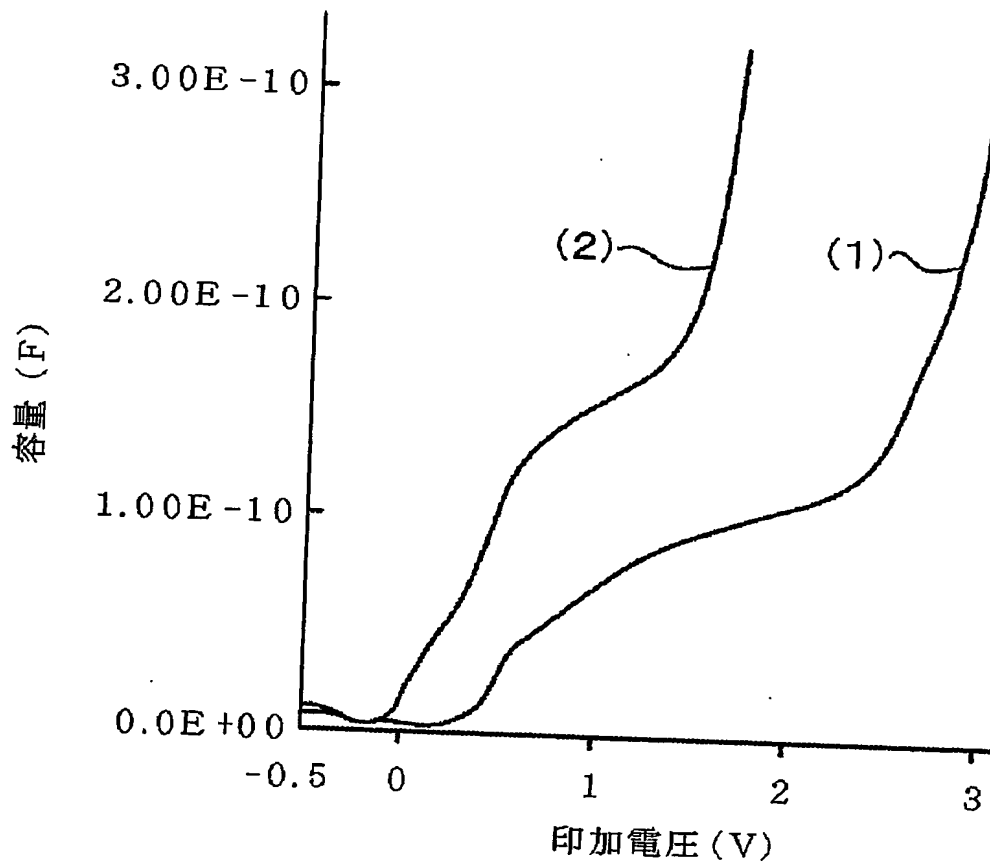


【図 8】

実施例 4 (SiH<sub>4</sub> 使用 + NH<sub>3</sub> アニール)



【図9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 例えばMOSFETのゲート酸化膜などの高誘電率膜として有効なハフニウム化合物膜を成膜するにあたり、結晶化温度が高いハフニウム化合物膜を成膜できる手法を提供すること。

【解決手段】 減圧雰囲気かつ加熱雰囲気下において反応容器内にてハフニウム有機化合物の蒸気とモノシランガスあるいはジシランガスとを反応させてハフニウムシリケート膜を基板上に成膜する。得られた高誘電率膜はシリコンによる結晶化抑制の働きにより結晶化温度が高い。またハフニウム酸化膜やハフニウムシリケート膜をアンモニアガスにより加熱雰囲気下でアニールする。

【選択図】 図1

特願 2003-104437

ページ: 1/E

出願人履歴情報

識別番号

[000219967]

1. 変更年月日

2003年 4月 2日

[変更理由]

住所変更

住所

東京都港区赤坂五丁目3番6号

氏名

東京エレクトロン株式会社